

半導体基板

輸出令別表第1の7の項(18)、省令第6条第十八号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ
炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの
半導体基板又はインゴット、ブールその他のプリフォーム

輸出令別表第1の7の項(22)、省令第6条第二十二号、第二十四号
多結晶の基板

輸出令別表第1の7の項(23)、省令第6条第二十三号、第二十四号

貨物名：

メーカー名：

型及び銘柄：

パラメータシート
エレクトロニクス・貨物
様式：6-18/-22/-23/-24 (1/5)
©CISTEC2025.05.28
(令和7年5月28日施行政省令等対応)

質問事項	回答		備考
1. 7の項(22)、省令第6条第二十二号の判定			
(1-1) 当該貨物は、ウエハーか？（注3）（注4）	☐ いいえ ↓	☐ はい ←(1-3)項へ	
(1-2) 次のいずれかのインゴット、ブール若しくはその他のプリフォームか？ ・炭化けい素(SiC) ・窒化ガリウム(GaN) ・窒化アルミニウム(AlN) ・窒化アルミニウムガリウム (AlGaN) ・三酸化二ガリウム (Ga ₂ O ₃) ・ダイヤモンド	☐ いいえ ←判定結果へ	☐ はい 物質名 () ↓	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)
20℃における電気抵抗率が10,000オームセンチメートルを超えるものか？	☐ いいえ 電気抵抗率 ()Ω cm ←判定結果へ	☐ はい 電気抵抗率 ()Ω cm ←判定結果へ	
(1-3) 当該貨物は、基板の上に層が付いているものか？	☐ いいえ ↓	☐ はい ←(2-1)項へ	層 基板 (はい)の貨物の例
(1-4) 次のいずれかの半導体基板か？ ・炭化けい素(SiC) ・窒化ガリウム(GaN) ・窒化アルミニウム(AlN) ・窒化アルミニウムガリウム (AlGaN) ・三酸化二ガリウム (Ga ₂ O ₃) ・ダイヤモンド	☐ いいえ ←判定結果へ	☐ はい 物質名 () ↓	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)
20℃における電気抵抗率が10,000オームセンチメートルを超えるものか？	☐ いいえ 電気抵抗率 ()Ω cm ←判定結果へ	☐ はい 電気抵抗率 ()Ω cm ←判定結果へ	

半導体基板

輸出令別表第1の7の項(18)、省令第6条第十八号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ

炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの

半導体基板又はインゴット、ブールその他のプリフォーム

輸出令別表第1の7の項(22)、省令第6条第二十二号、第二十四号

多結晶の基板

輸出令別表第1の7の項(23)、省令第6条第二十三号、第二十四号

パラメータシート
エレクトロニクス・貨物
様式:6-18/-22/-23/-24

(2/5)

©CISTEC2025.05.28

(令和7年5月28日施行政省令等対応)

質 問 事 項	回	答	備 考
2. 7の項(18)、省令第6条第十八号の判定 (十八号の二に該当するものを除く。) (2-1) 基板の上に付いている層は単結晶層か？(注5)	☐ いいえ ↓	☐ はい ←(2-3)項へ	単結晶層 基板 (はい)の貨物の例
(2-2) その層は容易に分離可能か？	☐ いいえ ←判定結果へ	☐ はい ↓	
(2-3) 基板の上に付いている層は単層か？	☐ いいえ ↓	☐ はい ←(3-1)項へ	層 基板
(2-4) 基板の上に付いている多層膜は全てが基板と同一物質か？	☐ いいえ ↓	☐ はい ←(3-1)項へ	層(物質A) 層(物質A) 基板(物質A)
(2-5) 基板上に次のいずれかに該当する物質の結晶がエピタキシャル成長されているものか？ イ シリコン(Si) ロ ゲルマニウム(Ge) ハ 炭化けい素(SiC) ニ Ⅲ－Ⅴ族化合物(ガリウム又はインジウムの化合物に限る)(注:ニの除外条件は、下記☆印参照) ホ 三酸化二ガリウム(Ga ₂ O ₃) ヘ ダイヤモンド	☐ いいえ ↓	☐ はい 物質名 (_____) ←判定結果へ	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)

半導体基板

輸出令別表第1の7の項(18)、省令第6条第十八号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ

炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの

半導体基板又はインゴット、ブールその他のプリフォーム

輸出令別表第1の7の項(22)、省令第6条第二十二号、第二十四号

多結晶の基板

輸出令別表第1の7の項(23)、省令第6条第二十三号、第二十四号

パラメータシート
エレクトロニクス・貨物
様式:6-18/-22/-23/-24

(3/5)

©CISTEC2025.05.28

(令和7年5月28日施行政省令等対応)

質 問 事 項	回	答	備 考
3. 7の項(23)、省令第6条第二十三号の判定			
(3-1) 下地となる基板は、20℃における電気抵抗率が10,000オームセンチメートルを超えるものか？	☐ いいえ 電気抵抗率 ()Ω cm ←判定結果へ	☐ はい 電気抵抗率 ()Ω cm ↓	
(3-2) 下地となる基板は多結晶基板又は多結晶セラミック基板か？	☐ いいえ ←(4-1)項へ	☐ はい ↓	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)
(3-3) 基板表面に次のいずれかの非エピタキシャル単結晶層を少なくとも1層以上有するか？ ・シリコン(Si) ・炭化けい素(SiC) ・窒化ガリウム(GaN) ・窒化アルミニウム(AlN) ・窒化アルミニウムガリウム (AlGaIn) ・三酸化二ガリウム (Ga ₂ O ₃) ・ダイヤモンド	☐ いいえ ←(4-1)項へ	☐ はい 物質名 () ↓	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由) 非エピ層 基板 (はい)の貨物の例
(3-4) 基板上に、次のいずれかのエピタキシャル層を少なくとも1層以上有するものか？ ・炭化けい素(SiC) ・窒化ガリウム(GaN) ・窒化アルミニウム(AlN) ・窒化アルミニウムガリウム (AlGaIn) ・三酸化二ガリウム (Ga ₂ O ₃) ・ダイヤモンド		☐ はい 物質名 () ↓ ←(5-1)項へ ☐ いいえ ←判定結果へ 7の項(23)、省令第6条第二十三号に該当	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由) エピ層 非エピ層 基板 (はい)の貨物の例
4. 7の項(22)、省令第6条第二十二号及び第二十四号の判定			
(4-1) 下地となる基板は次のいずれかの半導体基板か？ ・炭化けい素(SiC) ・窒化ガリウム(GaN) ・窒化アルミニウム(AlN) ・窒化アルミニウムガリウム (AlGaIn) ・三酸化二ガリウム (Ga ₂ O ₃) ・ダイヤモンド	☐ いいえ ←判定結果へ	☐ はい 物質名 () ↓	層 基板
(4-2) 基板上に、次のいずれかのエピタキシャル層を少なくとも1層以上有するものか？ ・炭化けい素(SiC) ・窒化ガリウム(GaN) ・窒化アルミニウム(AlN) ・窒化アルミニウムガリウム (AlGaIn) ・三酸化二ガリウム (Ga ₂ O ₃) ・ダイヤモンド	☐ いいえ ←判定結果へ	☐ はい 物質名 () ↓ ←判定結果へ 7の項(22)、省令第6条第二十二号、第二十四号に該当	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)

半導体基板

輸出令別表第1の7の項(18)、省令第6条第十八号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ

炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの

半導体基板又はインゴット、ブールその他のプリフォーム

輸出令別表第1の7の項(22)、省令第6条第二十二号、第二十四号

多結晶の基板

輸出令別表第1の7の項(23)、省令第6条第二十三号、第二十四号

パラメータシート
エレクトロニクス・貨物
様式: 6-18/-22/-23/-24 (4/5)
©CISTEC2025.05.28
(令和7年5月28日施行政省令等対応)

質 問 事 項	回 答		備 考
5. 7の項(22)～(23)、省令第6条第二十二号～第二十四号の判定 (5-1) 下地となる基板は次のいずれかの半導体基板か？ ・炭化けい素(SiC) ・窒化ガリウム(GaN) ・窒化アルミニウム(AlN) ・窒化アルミニウムガリウム (AlGaN) ・三酸化二ガリウム (Ga ₂ O ₃) ・ダイヤモンド	☐ はい	物質名 (_____) ←判定結果へ 7の項(22)、省令第6条第二十二号、第二十四号に該当	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由) 層 基板
判定結果	☐ 非該当	☐ 該当	
該当項番	① 輸出令別表第1の7の項(_____) ② 貨物等省令の条項等の番号等: 省令第6条第 _____ 号 (_____) 省令第6条第 _____ 号 (_____) [_____ に該当項目を記入する]		

- 注1: 回答の下の()内には、該・非に拘わらず物質名または数値を記入する。数値は、設計値、カタログ又は仕様書等の数値を記入する。
- 注2: 回答欄右欄の「☐ はい」又は「☐ いいえ」にチェックされた場合は該当と判定される。
- 注3: パターンが形成されたウエハ―は、集積回路/素子等として判定する(工程途中のものは設計意図により判定)。また、レジストが付いたウエハ―の場合は、第6条第十九号での判定も必要。
- 注4: 同位体制御技術を用いて作られた半導体基板、インゴット、ブール、その他のプリフォームについては、様式: 6-18の2/-25/-26を参照。
- 注5: エピタキシャル層は単結晶層として判定する。

(☆印) 除外条件

窒化ガリウム(GaN)、窒化インジウムガリウム(InGaN)、窒化アルミニウムガリウム(AlGaN)、窒化インジウムアルミニウム(InAlN)、窒化インジウムアルミニウムガリウム(InAlGaN)、リン化ガリウム(GaP)、砒化ガリウム(GaAs)、砒化アルミニウムガリウム(AlGaAs)、リン化インジウム(InP)、リン化インジウムガリウム(InGaP)、リン化アルミニウムインジウム(AlInP)又はリン化インジウムガリウムアルミニウム(InGaAlP)
(元素の順番を問わない。)のP型エピタキシャル層を1層以上有する基板であって、当該P型エピタキシャル層がN型層に挟まれていないものは非該当となる。

(解釈)

「多層膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているもののうち、ヘテロエピタキシャル材料となるもの」:	
異種の半導体物質が同一結晶方位に結晶構造を連続させて積層成長してできた多層の結晶成長層を有する基板をいう。	
多層膜からなるヘテロエピタキシャル成長結晶を有する基板からなる材料を含む。	
「貨物等省令第6条第十八号から第十九号まで、第二十二号から第二十四号まで及び第二十六号中の基板」:	
個別部品又は集積回路を、基板上若しくはその中に配置できるようになっている薄板状のものであって、相互接続の有無によらないものをいう。	
「Ⅲ－Ⅴ族化合物」:	
ほう素、アルミニウム、ガリウム、インジウム、タリウム又はこれらの組合せと窒素、磷、砒素、アンチモン、ビスマス又はこれらの組合せとの化合物をいう。	

半導体基板

輸出令別表第1の7の項(18)、省令第6条第十八号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ

炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの

半導体基板又はインゴット、ブールその他のプリフォーム

輸出令別表第1の7の項(22)、省令第6条第二十二号、第二十四号

多結晶の基板

輸出令別表第1の7の項(23)、省令第6条第二十三号、第二十四号

パラメータシート
エレクトロニクス・貨物
様式: 6-18/-22/-23/-24

(5/5)

©CISTEC2025.05.28

(令和7年5月28日施行政省令等対応)

(参考情報) 特別一般包括輸出許可の適用可否判断用チェック欄

質 問 事 項	回	答	備考
窒化ガリウム(GaN)を基板とするものか？ (注: エピタキシャル/非エピタキシャル層のみに窒化ガリウムを含む基板は対象としない)	☐ いいえ	☐ はい ↓ (注6) 参照	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)

注6: 「はい」の場合、特別一般包括輸出許可を適用できる仕向地が限定されるのでご注意ください。

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

作成責任者: (作成年月日 年 月 日)

会社名

所属・役職

(フリガナ)

氏 名

印

電 話